Z25 - Optyczny wzmacniacz światłowodowy EDFA

Ćwiczenie dotyczy badania zjawisk absorpcji i wzmocnienia oraz ich nasycenia w aktywnym ośrodku optycznym w postaci światłowodu, którego rdzeń domieszkowany jest jonami erbu Er^{3+} . Światłowody tego typu, zwane EDF (*ang. erbium – doped fiber*), pompowane są zewnętrznymi źródłami światła i stanowią ośrodki wzmacniające tzw. EDFA, powszechnie wykorzystywane w systemach komunikacji światłowodowej oraz w laserach dużej mocy.

Słowa kluczowe: światłowód domieszkowany erbem (EDF), emisja spontaniczna, emisja wymuszona, absorpcja, inwersja obsadzeń, nasycenie absorpcji, nasycenie wzmocnienia, równania kinetyczne, równanie transportu promieniowania, funkcja W Lamberta.

Spis treści

1	Cel ćwiczenia	2
2	Aparatura i materiały	2
3	Zasady postępowania z elementami światłowodowymi oraz zasady BHP	4
4	Przebieg pomiarów4.1Charakterystyka źródeł światła – opcjonalnie4.2Badanie właściwości absorpcyjnych światłowodu EDF4.3Badanie właściwości wzmacniających światłowodu EDF	4 4 5 6
5	Podstawy teoretyczne 5.1 Oddziaływanie światła z materią 5.2 Współczynniki absorpcji i wzmocnienia 5.3 Pompowanie optyczne i wytwarzanie inwersji obsadzeń 5.3.1 Pompowanie ośrodka przy braku wzmacnianego strumienia fotonów 5.3.2 Pompowanie ośrodka w obecności wzmacnianego strumienia fotonów 5.3.3 Pompowanie optyczne w układzie 3-poziomowym 5.4 Transport promieniowania w ośrodku aktywnym optycznie 5.5 Włókno domieszkowane erbem jako ośrodek wzmacniający	7 8 9 9 10 11 13 14
6	DODATKI 6.1 Procedura uruchamiania i obsługi diód laserowych	16
	firmy Amonics	$\begin{array}{c} 16 \\ 17 \end{array}$

1 Cel ćwiczenia

W tym ćwiczeniu zadaniem studenta jest (w zależności od ustalonego wcześniej programu):

- 1. Zbadanie właściwości optycznych światłowodu EDF, w tym wyznaczenie liniowego współczynnika absorpcji γ_0 dla $\lambda = 1550$ nm, wartości mocy (P_s) / natężenia (I_s) wiązki światła nasycającej współczynnik absorpcji oraz koncentracji jonów Er^{3+} jako domieszek w światłowodzie EDF.
- 2. Zbadanie właściwości wzmacniających włókna EDF w zależności od mocy wiązek pompującej oraz wzmacnianej/sygnałowej.

W trakcie ćwiczenia studenci zapoznają się z własnościami i zasadami działania światłowodów oraz takich elementów techniki światłowodowej jak kable światłowodowe, sprzęgacze, izolatory i cyrkulatory optyczne, multipleksery i demultipleksery. Istotne jest także nabycie umiejętnośi obchodzenia się i posługiwania wyżej wymienionymi elementami. Szczególny nacisk w tym ćwiczeniu położony jest na pogłębienie wiedzy z zakresu wzmacniaczy optycznych i laserów z uwzględnieniem procesów absorpcji, emisji wymuszonej i spontanicznej oraz zjawiska inwersji obsadzeń i jej nasycenia. Symulacja absorpcji i wzmocnienia wiązki sygnałowej odbywa się z wykorzystaniem równań kinetycznych (ang. rate equations) i równania transportu promieniowania, które opisują obsadzenia poziomów energetycznych ośrodka wzmacniającego – w tym przypadku jonów Er^{3+} w matrycy szklanej. Wyniki symulacji komputerowych są następnie porównywane z wynikami doświadczeń.

2 Aparatura i materiały

Aparatura i materiały zostały przedstawione na Rys. 1–2 i w zależności od zestawu pomiarowego, należą do nich: dioda superluminescencyjna (tzw. SLED) generująca promieniowanie w zakresie długości fal 1510-1590 nm o mocy optycznej $P \cong 500 \ \mu$ W, laser diodowy generujący promieniowanie o długości fali $\lambda = 1550$ nm i mocy $P \cong 1$ mW, światłowód typu EDF o długości L = 10 m (średnica rdzenia 14 μ m), laser diodowy generujący promieniowanie o długości fali ($\lambda = 980$ nm) do pompowania światłowodu EDF i mocy $P \cong 100$ mW, spektrometr optyczny I-MON firmy Ibsen na zakres spektralny 1500-1600 nm, osłabiacz optyczny, światłowodowa siatka Bragga, 3- i 4-portowe sprzęgacze światłowodowe, multiplekser WDM 980nm/1550nm, cyrkulator światłowodowe, dowy, izolator optyczny, światłowodowe, miernik mocy lasera, fotodioda InGaAs (800-1700 nm) z wejściem światłowodowym, miliwoltomierz, zestaw do czyszczenia elementów światłowodowych, okulary ochronne na zakres 800–1600 nm oraz komputer do sterowania spektrometrem i akwizycji danych.



- 1. laser diodowy (pompujący) 980 nm 2. laser diodowy 1550 nm 3. wzmacniacz światłowodowy EDF zawierający: izolatory optyczne, światłowód EDF, układ zwielokrotnienia falowego WDM, filtr optyczny
- 4. miernik mocy lasera
 5. spektrometr optyczny I-MON
 6. karta wizualizująca promieniowanie podczerwone

Rysunek 1: Aparatura - zestaw I.



- Waciki do czyszczenia optyki
 Isopropanol
 SLED

- 4. Laser diodowy 1550nm
- 5. Mikroskop 6. Urządzenie do czyszczenia
- końcówek światłowodów
- Karta konwertująca promienio-wanie podczerwone na widzialne
 Sprzęgacze, izolatory optyczne światłowodowa siatka Bragga
- 9. Miernik mocy lasera
- Głowica miernika mocy
 Spektrometr I-MON
 Światłowód

Rysunek 2: Aparatura - zestaw II.

- 13. Multimetr
- Iaser pompujący 980nm z układem zasilania, sprzęgacz WDM, światłowód domieszkowany erbem

- Regulowany osłabiacz optyczny VOA
 Kable światłowodowe
 Okulary ochronne na zakres 800-1600nm
 Fotodioda InGaAs na zakres 800-1700nm

3 Zasady postępowania z elementami światłowodowymi oraz zasady BHP

Ponieważ w ćwiczeniu wykorzystywane jest promieniowanie laserowe oraz niezwykle delikatne elementy optyczne, wobec tego od studenta wymaga się stosowania do poniższych zasad.

- Nie wolno patrzeć wprost w wiązkę laserową i światłowody do których wprowadzono światło lasera, gdyż może to doprowadzić do trwałej utraty wzroku.
- Nie wolno dotykać końcówek światłowodów ani innych powierzchni optycznych, gdyż może to spowodować ich trwałe uszkodzenie.
- Końcówki nieużywanych światłowodów i wejścia elementów zestawu światłowodowego oraz spektrometrów jeśli nie są używane należy bezwględnie zabezpieczać odpowiednimi zaślepkami.
- Nie zginać światłowodów w pętle o średnicy mniejszej niż 4 cm.
- Przed każdym podłączeniem sprawdzać, za pomocą mikroskopu, końcówki kabli światłowodowych i w razie potrzeby należy je przeczyścić. Typowe mikroskopowe obrazy końcówek światłowodu przedstawia Rys. 3.
- Uruchamianie laserów i spektrometrów może się odbywać wyłącznie za zgodą i przy obecności prowadzącego ćwiczenie.



Rysunek 3: Obrazy mikroskopowe końcówek światłowodów: a) uszkodzona - światłowód wymaga wymiany, b) zabrudzona - wymaga wyczyszczenia, c) czysta.

4 Przebieg pomiarów

Przed rozpoczęciem zasadniczej części ćwiczeń, opiekun przeprowadza krótkie szkolenie dotyczące obchodzenia się z elementami światłowodowymi, ich łączenia oraz oceny jakości końcówek światłowodów i ich czyszczenia. Ponadto, studenci zobowiązani są zapoznać się z obsługą laserów diodowych i urządzeń diagnostycznych takich jak analizator widma (spektrometr optyczny) i miernik mocy lasera, wykorzystując w tym celu dostarczone instrukcje obsługi. W dalszej kolejności, po uruchomieniu komputera, należy założyć kartotekę d:\users\nazwisko_studenta, w której będą zapisywane wszelkie gromadzone dane. Następnie należy uruchomić program do obsługi spektrometru I-MON (skrót na pulpicie) i zapoznać się z jego działaniem.

4.1 Charakterystyka źródeł światła – opcjonalnie

W celu określenia mocy optycznej używanych źródeł światła należy dla każdego z nich z osobna:

- zmierzyć zależność mocy optycznej od prądu zasilania używając miernika mocy lasera; maksymalne wartości prądów zasilania wynoszą zestaw I: laser sygnałowy @1550 nm - 35.0 mA, laser pompujący @980 nm - 250 mA. zestaw II: laser sygnałowy @1550 nm - 19.5 mA, laser pompujący @980 nm - 235 mA tj. 1.2 V na wyjściu monitorującym zasilanie diody. Moc optyczną mierzymy na końcu zwykłego światłowodu dołączonego do wyjścia badanego lasera.
- Wyznaczyć wartości prądów progowych dla badanych diód laserowych oraz zależności funkcyjne pomiędzy ich mocą optyczną a prądem zasilania.

UWAGA: we wszystkich pomiarach źródła światła 1550 nm łączymy z pozostałymi elementami światłowodowymi poprzez izolator optyczny.

4.2 Badanie właściwości absorpcyjnych światłowodu EDF

Schemat układu pomiarowego został przedstawiony na rysunkach 4 (zestaw I) i 5 (zestaw II).



Rysunek 4: Schemat układu pomiarowego do badania współczynników absorpcji i wzmocnienia dla światłowodu EDF (zestaw I).



Rysunek 5: Schemat układu pomiarowego do badania współczynników absorpcji i wzmocnienia światłowodu EDF (zestaw II).

• Wykorzystując laser diodowy @1550nm, spektrometr oraz miernik mocy lasera wyznaczyć zależność sygnału optycznego na wyjściu światłowodu EDF od jego mocy na wejściu tego światłowodu.

Zastanowić się nad odpowiednią metodyką przeprowadzenia tych pomiarów, w szczególności nad problemem wiarygodnego wyznaczenia mocy wiązki na wejściu do światłowodu EDF.

- Na podstawie zmierzonych zależności wyznaczyć współczynnik absorpcji i tłumienność (w dB/m) światłowodu oraz moc i natężenie nasycenia.
- Wyliczyć koncentrację zawartych w światłowodzie EDF jonów Er³⁺. W obliczeniach przyjąć, że przekrój czynny dla przejścia pomiędzy stanem podstawowym i wzbudzonym w strukturze energetycznej Er³⁺ o $\lambda_s = 1550$ nm, wynosi $\sigma = 2.5 \times 10^{-21}$ cm², średnica rdzenia światłowodu $2r = 14 \ \mu$ m, jego długość L = 10 m, a współczynnik wypełnienia rdzenia wiązką pompującą $\Gamma = 0.4$.

4.3 Badanie właściwości wzmacniających światłowodu EDF

Układ doświadczalny został przedstawiony na rysunkach 4 (zestaw I) i 5 (zestaw II). Badania właściwości wzmacniających światłowodu EDF nalezy przeprowadzić w sposób opisany poniżej.

• Włączyć laser pompujący @980 nm i dla 3 różnych wartości jego mocy zarejestrować zależność mocy wiązki sygnałowej @1550nm, mierzonej na wyjściu światłowodu EDF, od jej mocy na wejściu tego światłowodu.

W przypadku zestawu I, moc optyczną lasera @1550nm regulujemy prądem zasilania diody i/lub pokrętłem 6 zaznaczonym na rysunku 15. Natomiast moc ooptyczną lasera @980nm regulujemy wyłącznie prądem zasilania diody. Z kolei, w przypadku zestawu II, moc optyczną lasera @980nm regulujemy prądem zasilania diody, a lasera @1550nm za pomocą regulowanego dodatkowego zewnętrznego osłabiacza wiązki VOA.

- Dla kilku wartości mocy wiązki sygnałowej @1550nm na wejściu EDF zarejestrować zależność jej mocy na wyjściu światłowodu EDF od mocy wiązki pompującej @980nm.
- Na podstawie wyników pomiarów wyznaczyć moc progową wiązki pompującej dla której wzmocnienie wynosi 0 dB.
- opcjonalnie Wykonać odpowiednie symulacje numeryczne zbadanych zależności poprzez rozwiązanie układu równań kinetycznych i równania transportu promieniowania, zakładając jednocześnie trójpoziomową strukturę jonu Er³⁺. W obliczeniach przyjąć parametry światłowodu EDF jak to podano wyżej i używając wyznaczonych wcześniej wartości koncentracji jonów Er³⁺ i mocy/natężenia nasycenia wiązki sygnałowej. Ponadto, przyjąć, że przekrój czynny na przejście pomiędzy stanem podstawowym a wzbudzonym na długości fali $\lambda_p = 980$ nm wynosi $\sigma = 8.85 \times 10^{-21}$ cm².

5 Podstawy teoretyczne

Od samego powstania, w końcu lat 80-tych ubiegłego wieku, włókna domieszkowane erbem są niezwykle uniwersalnym materiałem znajdującym szereg zastosowań w szerokopasmowych źródłach światła, wzmacniaczach szerokopasmowych czy laserach przestrajalnych.

Szerokopasmowe źródła światła znajdują zastosowanie np. w żyroskopach optycznych, tomografach optycznych lub fotometrach. Włóknowy wzmacniacz erbowy (EDFA – erbium-doped fiber amplifier) to z kolei pierwszy udany wzmacniacz optyczny, który zrewolucjonizował przemysł telekomunikacyjny na początku lat 90-tych. Obecnie EDFA są powszechnie używane w systemach komunikacji światłowodowej, w szczególności w systemach z podziałem długości fal (WDM – wavelength division multiplexing). Włóknowe lasery erbowe (EDFL – erbium-doped fiber laser) to dzisiaj jedne z najbardziej popularnych laserów ze względu na bardzo dobrą jakość wiązki, szeroki zakres przestrajania długości fali, stosunkowo małe rozmiary w porównaniu z generowanymi mocami i niską cenę.

5.1 Oddziaływanie światła z materią

Rozważmy wnękę rezonansową o objętości V, w której znajduje się atom wraz z polem promieniowania o częstotliwości ν . Energie poziomów atomu przyjmują wartości E_1 dla stanu dolnego oraz E_2 dla stanu górnego. Załóżmy ponadto, że pole promieniowania jest w rezonansie z atomem, czyli $\Delta E = E_2 - E_1 = h\nu$. W takiej sytuacji możliwe są trzy scenariusze oddziaływania pomiędzy polem a atomem przedstawione na Rys. 6. Atom w stanie podstawowym może zaabsorbować foton z pola promieniowania i przejść do stanu górnego, który to proces nazywamy **absorpcją**. Gęstość prawdopodobieństwa absorpcji zależy od gęstości strumienia fotonów $\phi(\nu)$ oraz przekroju czynnego $\sigma(\nu)$ na przejście pomiędzy stanami o energiach E_1 i E_2

$$P_{\rm ab} = \phi \cdot \sigma(\nu). \tag{1}$$

Z kolei atom w stanie górnym E_2 , pod wpływem fotonu pola promieniowania, może przejść do stanu dolnego E_1 emitując jednocześnie foton, którego własności są identyczne jak fotonu wymuszającego. Proces taki nazywamy **emisją wymuszoną**. Gęstość prawdopodobieństwa emisji wymuszonej, tak samo jak absorpcji, zależy od gęstości strumienia fotonów we wnęce oraz od przekroju czynnego $\sigma(\nu)$

$$P_{\rm ew} = \phi \cdot \sigma(\nu). \tag{2}$$

Ponieważ przekroje czynne na absorpcję i emisję wymuszoną są identyczne, więc

$$P_{\rm ab} = P_{\rm ew} \equiv W_i. \tag{3}$$

Występująca w równaniach (1) i (2) gęstość strumienia fotonów oznacza liczbę fotonów padających na jednostkę powierzchni w jednostkowym czasie i wynosi

$$\phi = \frac{I}{h\nu} = \frac{nc}{V} \left[\frac{\text{liczba fotonow}}{\text{cm}^2 \cdot \text{s}} \right],\tag{4}$$



gdzie $I \left[W/cm^2 \right]$ to natężenie pola promieniowania, a n oznacza liczbę fotonów tego pola.

Atom pozostający w górnym stanie może również, w sposób spontaniczny pod wpływem *pola* próżni, przejść do stanu dolnego emitując foton o częstotliwości ν , który dodaje się do fotonów pola promieniowania we wnęce. Powstałe fotony nie są jednak ani ukierunkowane ani spójne. Proces taki nazywamy **emisją spontaniczną** i nie zależy on od liczby fotonów we wnęce. Gęstość prawdopodobieństwa emisji spontanicznej

$$P_{\rm sp} = A_{21} = \frac{1}{\tau},\tag{5}$$

gdzie A_{21} to współczynnik Einsteina, a τ to średni czas życia poziomu w stanie o energii E_2 .

5.2 Współczynniki absorpcji i wzmocnienia

Jeżeli ośrodek atomowy (Rys. 7), w postaci atomów dwupoziomowych o gęstościach obsadzeń N_1 i N_2 , oddziałuje ze strumieniem fotonów o gęstości ϕ , to liczba kreowanych/anihilowanych na sekundę fotonów w jednostkowej objętości wynosi

$$N_2 W_i - N_1 W_i \equiv \Delta N W_i, \tag{6}$$

gdzie $\Delta N = N_2 - N_1$ jest różnicą gęstości obsadzeń. Jeżel
i $\Delta N < 0$ to obsadzenie dolnego



Rysunek 7: Strumień fotonów o gęstości $\phi(\nu)$ oddziałuje z ośrodkiem atomowym, w którym gęstości obsadzeń poszczególnych poziomów wynoszą N_1 i N_2 .

poziomu przewyższa obsadzenie poziomu górnego i procesy absorpcji dominują nad procesami emisji wymuszonej, co powoduje osłabienie padającego strumienia fotonów. Taki ośrodek nazywamy ośrodkiem absorpcyjnym. Gdy $\Delta N > 0$, to obsadzenie górnego poziomu atomu jest większe niż dolnego, co nazywamy **inwersją obsadzeń**. Wówczas procesy emisji wymuszonej przeważają nad procesami absorpcji czego wynikiem jest wzmocnienie padającego strumienia fotonów, a ośrodek nazywamy wzmacniającym. Wreszcie, gdy $\Delta N = 0$ to procesy absorpcji są zrównoważone przez procesy emisji wymuszonej i wypadkowy strumień fotonów nie ulega zmianie. Taki ośrodek nazywamy przezroczystym.

W stanie równowagi termodynamicznej, w temperaturze T, względne obsadzenie poziomów atomowych opisywane jest rozkładem Maxwella-Boltzmanna

$$\frac{N_2}{N_1} \propto e^{-(E_2 - E_1)/(k_B T)} = e^{-h\nu/(k_B T)} < 1$$
(7)

i dlatego obsadzenie stanu górnego jest zawsze mniejsze niż dolnego. Ośrodek pozostający w równowadze termodynamicznej jest ośrodkiem absorpcyjnym. Ilościowo, zmiana gęstości strumienia fotonów na długości dz ośrodka wynosi

$$\phi(z+dz) - \phi(z) = \Delta N W_i \, dz = \Delta N \phi \, \sigma \, dz. \tag{8}$$

Zatem, w odległości z

$$\phi(z) = \phi(0) e^{-\alpha z}, \quad I(z) = I(0) e^{-\alpha z},$$
(9)

gdzie $\alpha = -\Delta N \cdot \sigma(\nu) > 0$ to **współczynnik absorpcji** ośrodka opisujący osłabienie strumienia fotonów na jednostkę długości, a $\phi(0)$ to gęstość padającego strumienia fotonów. W przypadku ośrodka wzmacniającego $\alpha = -\gamma < 0$ i γ nazywamy **współczynnikiem wzmocnienia**. Powyższa relacja pozostaje prawdziwa gdy różnica obsadzeń ΔN jest stała i nie zależy od gęstości strumienia fotonów, co zachodzi dla małych wartości tego strumienia.

Często dla opisu własności wzmacniających ośrodka używa się wielkości zwanej wzmocnieniem

$$G = \frac{10}{L} \log \frac{\phi(L)}{\phi(0)} = \frac{10}{L} \log \frac{I(L)}{I(0)},$$
(10)

której jednostką jest dB/m (decybel/m).

5.3 Pompowanie optyczne i wytwarzanie inwersji obsadzeń

Aby otrzymać ośrodek wzmacniający, czyli aby wytworzyć inwersję obsadzeń, należy użyć zewnętrznego źródła energii, potocznie nazywanego *pompą*. Energia dostarczana do ośrodka za pomocą pompy zostaje w efekcie zużyta na zwiększenie wyjściowego strumienia fotonów. Pompa dostarcza energię poprzez wzbudzenie w atomach elektronów ze stanów niższych do wyższych. Stanu inwersji obsadzeń nie da się jednak uzyskać "pompując" atomy bezpośrednio z poziomu dolnego do górnego, ale wymaga to zaangażowania dodatkowych poziomów pośrednich. Jeśli zewnętrznym źródłem energii jest źródło światła, to proces prowadzący do wytworzenia inwersji obsadzeń nazywamy **pompowaniem optycznym**.

5.3.1 Pompowanie ośrodka przy braku wzmacnianego strumienia fotonów

Dynamika procesu pompowania jest opisywana za pomocą równań kinetycznych (ang. rate equations), które podają szybkości zmian gęstości obsadzeń poziomów energetycznych atomu w wyniku pompowania oraz przejść promienistych i bezpromienistych.



Rysunek 8: Schemat pompowania bez obecności pola promieniowania. R_1, R_2 to odpowiednio szybkości pompowania atomów z poziomu 1 oraz na poziom 2; τ_{21} to średni czas relaksacji stanu 2 do stanu 1, na który składają się średnie czasy relaksacji spontanicznej $\tau_{\rm sp}$ oraz przejść bezpromienistych $\tau_{\rm nr}$; τ_{20} to średni czas relaksacji stanu 2 do stanu podstawowego; τ_2 to średni czas życia poziomu 2 (uwzględnia τ_{21} oraz τ_{20}); τ_1 to średni czas życia poziomu 1. Szybkości pompowania atomów z poziomu 1 – R_1 oraz na poziom 2 – R_2 są podawane w cm⁻³ · s⁻¹.

Szybkości zmian obsadzeń poziomów z Rys. 8, zapisane za pomocą równań kinetycznych, wynoszą

$$\frac{dN_1}{dt} = -R_1 - \frac{N_1}{\tau_1} + \frac{N_2}{\tau_{21}}
\frac{dN_2}{dt} = R_2 - \frac{N_2}{\tau_2}.$$
(11)

W warunkach stanu stacjonarnego, tzn. gdy $dN_1/dt = dN_2/dt = 0$, rozwiązania powyższego układu równań pozwalają wyznaczyć różnicę obsadzeń

$$N_2 - N_1 \equiv \Delta N_0 = R_2 \tau_2 \left(1 - \frac{\tau_1}{\tau_{21}} \right) + R_1 \tau_1.$$
(12)

Jak wynika z równania (12), dużą inwersję obsadzeń można otrzymać gdy:

- R_1 , R_2 przyjmują duże wartości, czyli gdy poziom górny i dolny są odpowiednio szybko obsadzany i szybko opróżniany na skutek pompowania,
- $\tau_{21} \gg \tau_1$ czyli czas życia poziomu dolnego jest dużo krótszy od czasu życia poziomu górnego.

Warunki powyższe oznaczają szybkie obsadzanie i wolne opróżnianie poziomu górnego i odwrotnie, wolne obsadzanie i szybkie opróżnianie poziomu dolnego, co pozwala na utrzymywanie się dużej różnicy gęstości obsadzeń. W idealistycznej sytuacji, gdy opróżnianie poziomu górnego zachodzi wyłącznie poprzez przejścia radiacyjne na poziom dolny ($\tau_2 = \tau_{sp}$) i czas życia tego poziomu jest znacznie dłuższy niż poziomu dolnego ($\tau_{sp} \gg \tau_1$) to

$$\Delta N_0 \approx R_2 \tau_2 + R_1 \tau_1 = R_2 \tau_{\rm sp} + R_1 \tau_1.$$
(13)

Gdy dodatkowo $R_1 = 0$ lub $R_1 \ll R_2 (\tau_{\rm sp} / \tau_1)$, to wówczas

$$\Delta N_0 \approx R_2 \tau_{\rm sp},\tag{14}$$

czyli różnica obsadzeń jest wprost proporcjonalna do szybkości obsadzania poziomu górnego.

5.3.2 Pompowanie ośrodka w obecności wzmacnianego strumienia fotonów

Obecność strumienia fotonów o częstotliwości ν na wejściu ośrodka sprawia, że przejścia pomiędzy poziomami 1 i 2 mogą zachodzić także na skutek absorpcji i emisji wymuszonej. Gęstość prawdopodobieństwa zajścia takich procesów wynosi W_i , tak jak to było omawiane wcześniej.



Rysunek 9: Schemat pompowania w obecności strumienia fotonów o częstości rezonansowej z częstością przejścia pomiędzy poziomami 1 i 2. R_1, R_2 to odpowiednio szybkość pompowania atomów z poziomu 1 oraz na poziom 2; τ_{21} to średni czas relaksacji stanu 2 do stanu 1; τ_{20} to średni czas relaksacji stanu 2 do stanu podstawowego; τ_2 to średni czas życia poziomu 2 (uwzględnia τ_{21} oraz τ_{20}); τ_1 to średni czas życia poziomu 1; W_i to gęstość prawdopodobieństwa przejść pomiędzy poziomami 1 i 2.

Równania (11) na zmianę gęstości obsadzeń zostają rozszerzone o procesy absorpcji i emisji wymuszonej będące źródłem dodatkowego wzrostu i spadku gęstości obsadzeń poziomów

$$\frac{dN_1}{dt} = -R_1 - \frac{N_1}{\tau_1} + \frac{N_2}{\tau_{21}} + N_2 W_i - N_1 W_i$$

$$\frac{dN_2}{dt} = R_2 - \frac{N_2}{\tau_2} - N_2 W_i + N_1 W_i.$$
(15)

W stanie stacjonarnym, rozwiązania układu równań (15) dają różnicę gęstości obsadzeń

$$N_2 - N_1 \equiv \Delta N = \frac{\Delta N_0}{1 + \tau_{\rm s} W_i}.\tag{16}$$

 ΔN_0 jest gęstością obsadzeń w sytuacji bez strumienia fotonów o częstotliwości ν (równanie (12)), natomiast $\tau_{\rm s} = \tau_2 + \tau_1 (1 - \tau_2/\tau_{21}) > 0$ jest tak zwanym czasem charakterystycznym. Stała $\tau_{\rm s}$ podaje wartość gęstości prawdopodobieństwa W_i , dla której różnica obsadzeń maleje do połowy wartości ΔN_0 . Ponieważ $W_i = \phi \cdot \sigma(\nu)$ to równanie (16) można zapisać jako

$$\Delta N = \frac{\Delta N_0}{1 + \phi/\phi_s} = \frac{\Delta N_0}{1 + I/I_s}.$$
(17)

W powyższym równaniu $\phi_{\rm s} = 1/(\tau_{\rm s} \cdot \sigma)$ i oznacza taką gęstość strumienia fotonów, dla której różnica obsadzeń maleje do wartości $\Delta N_0/2$. Zmiana różnicy obsadzeń ΔN w zależności od gęstości strumienia fotonów została przedstawione na Rys. 10.



Rysunek 10: Zależność różnicy obsadzeń ΔN i współczynnika wzmocnienia γ od względnej gęstości strumienia fotonów.

W przypadku występowania niezerowego strumienia fotonów (o częstości przejścia $2 \leftrightarrow 1$), różnica obsadzeń w stanie stacjonarnym jest zawsze mniejsza niż w sytuacji przy braku tego strumienia. Gdy strumień ten jest bardzo słaby ($\phi \ll \phi_s$), wówczas $\Delta N \approx \Delta N_0$. Z kolei, dla silnego strumienia ($\phi \gg \phi_s$) ΔN dąży do zera. Dzieje się tak ponieważ na przejścia pomiędzy poziomami 1 i 2 główny wpływ mają absorpcja i emisja wymuszona o identycznej gęstości prawdopodobieństw. Dlatego też, nawet silne strumienie fotonów nie są w stanie zmienić dodatniej różnicy obsadzeń na ujemną i odwrotnie.

W takt za zmianami różnicy gęstości obsadzeń ΔN postępują zmiany współczynnika wzmocnienia

$$\gamma(\nu) = \Delta N \cdot \sigma(\nu) = \frac{\Delta N_0 \cdot \sigma(\nu)}{1 + \phi/\phi_{\rm s}} = \frac{\gamma_0(\nu)}{1 + \phi/\phi_{\rm s}} = \frac{\gamma_0(\nu)}{1 + I/I_{\rm s}},\tag{18}$$

gdzie $\gamma_0(\nu)$ to współczynnik wzmocnienia dla bardzo małych gęstości strumienia fotonów. Zmiany γ wraz ze wzrostem gęstości strumienia fotonów przedstawia rysunek 10. Współczynnik wzmocnienia, podobnie jak różnica obsadzeń, maleje wraz z gęstością fotonów pola promieniowania i w końcu ulega nasyceniu. Innymi słowy, zarówno absorpcja ($-\alpha = \gamma < 0$) jak i wzmocnienie ($\gamma > 0$) ośrodka ulegają nasyceniu i ośrodek staje się przezroczysty.

5.3.3 Pompowanie optyczne w układzie 3-poziomowym

Jak już wspomniano, wytworzenie inwersji obsadzeń wymaga zaangażowania dodatkowych poziomów w procesie pompowania. Najprostszym takim schematem jest układ 3-poziomowy, tak jak to pokazano na Rys. 11. Na tym schemacie poziomy 1 i 2 to poziomy przejścia wzmacniającego wejściowy strumień fotonów, przy czym poziom 1 jest jednocześnie poziomem podstawowym atomu lub bardzo bliskim podstawowego, tak że w warunkach równowagi termodynamicznej zawiera istotną część całkowitej populacji. Pompowanie poziomu 2 odbywa się – za pośrednictwem



Rysunek 11: Schemat układu 3-poziomowego.

krótkożyciowego poziomu 3 – z poziomu podstawowego. Do wzbudzenia tego stanu, w przypadku pompowania optycznego, używa się lamp wysokociśnieniowych lub innego lasera. Szybkość pompowania $R_1 = W_p N_1$, gdzie W_p oznacza gęstość prawdopodobieństwa przejścia zależną od gęstości strumienia fotonów pompującego źródła światła. Jednocześnie należy zaznaczyć, że strumień fotonów pompy będzie powodował opróżnianie poziomu 3 poprzez emisję wymuszoną z szybkością $R_3 = W_p N_3$. Zmiany gęstości obsadzeń w takim układzie opisują równania kinetyczne

$$\frac{dN_1}{dt} = -W_p N_1 + W_p N_3 + \frac{N_2}{\tau_{21}} + N_2 W_i - N_1 W_i$$

$$\frac{dN_2}{dt} = -\frac{N_2}{\tau_{21}} + \frac{N_3}{\tau_{32}} - N_2 W_i + N_1 W_i$$

$$\frac{dN_3}{dt} = W_p N_1 - W_p N_3 - \frac{N_3}{\tau_{32}}.$$
(19)

W stanie stacjonarnym, z rozwiązania powyższego układu równań kinetycznych, otrzymujemy różnice gęstości obsadzeń

$$N_2 - N_1 \equiv \Delta N = N_A \frac{(\tau_{21} - \tau_{32})W_p - 1}{1 + 2\tau_{21}W_i + (2\tau_{32} + \tau_{21})W_p + 3\tau_{21}\tau_{32}W_iW_p}$$
(20)

$$N_3 - N_1 \equiv \Delta N_{31} = -N_A \frac{\tau_{21} W_i + 1}{1 + 2\tau_{21} W_i + (2\tau_{32} + \tau_{21}) W_p + 3\tau_{21} \tau_{32} W_i W_p}.$$
 (21)

 $N_A = N_1 + N_2 + N_3$ jest sumą gęstości obsadzeń wszystkich poziomów, czyli gęstością atomów w ośrodku. Z równań tych wynika, że aby otrzymać inwersję obsadzeń ($\Delta N > 0$), to

- efektywny czas życia poziomu 3 musi być krótszy od czasu życia poziomu 2 ($\tau_{32} < \tau_{21}$),
- gęstość prawdopodobieństwa przejścia $W_p > 1/(\tau_{21} \tau_{32})$.

Przy braku wzmacnianego strumienia fotonów $(W_i = 0)$, interesująca nas różnica gęstości obsadzeń

$$\Delta N = N_A \frac{(\tau_{21} - \tau_{32})W_p - 1}{1 + (2\tau_{32} + \tau_{21})W_p}.$$
(22)

Jak łatwo zauważyć na Rys. 12, początkowo ΔN rośnie ze wzrostem strumienia fotonów pompy, a następnie ulega nasyceniu i osiąga stałą wartość równą $N_A(\tau_{21} - \tau_{32})/(2\tau_{32} + \tau_{21})$ zależną od stałych atomowych układu. Z kolei, niezerowy strumień fotonów na wejściu ($W_i > 0$) powoduje zmniejszanie różnicy gęstości obsadzeń, niezależnie od strumienia fotonów źródła pompującego. W granicy bardzo dużych wartości W_i następuje wyrównanie obsadzeń ($\Delta N \rightarrow 0$).



 W_p Rysunek 12: Względna różnica gęstości obsadzeń $\Delta N/N_A$ w zależności od gęstości strumienia fotonów źródła pompującego W_p (a) i wzmacnianego W_i (b). Symulacje przeprowadzone dla $\tau_{21}/\tau_{32} = 4$.

5.4 Transport promieniowania w ośrodku aktywnym optycznie

Do tej pory zakładaliśmy, że własności absorpcyjne/wzmaniające ośrodka są identyczne na całej jego długości. Jednak współczynniki absorpcji i wzmocnienia zależą bezpośrednio od istniejącej w danej objętości ośrodka różnicy gęstości obsadzeń, a ta zmienia się wraz ze zmianą gęstości propagujących w nim strumieni fotonów (wiązki pompująca i wzmacniana). Zmiany gęstości odpowiednich strumieni fotonów, w trakcie ich propagacji przez ośrodek, wynikają z kolei z oddziaływania z tym ośrodkiem. Takie wzajemne sprzężenie pomiędzy ośrodkiem a propagującymi w nim wiązkami światła należy zatem uwzględnić w równaniach transportu promieniowania i opisie sygnałów optycznych rejestrowanych na wyjściu z tego ośrodka. Jest to szczególnie istotne w przypadku długich ośrodków i gęstości strumieni fotonów porównywalnych z ich wartościami nasyceniowymi, co ma miejsce w przypadku tego ćwiczenia.

Dla ośrodka optycznie czynnego, którego właściwości zmieniają się pod wpływem rozchodzącej się w nim wiązki światła, równanie transportu promieniowania (8), dla natężenia wiązki, można zapisać w postaci

$$\frac{dI(z)}{dz} = \Delta N(z) I(z) \sigma$$
(23)

i uwzględniając równanie (17) na zmianę różnicy obsadzeń pod wpływem zewnętrznego strumienia światła, otrzymujemy

$$\frac{dI(z)}{dz} = \Delta N_0 \,\sigma \frac{I(z)}{1 + I(z)/I_s} = \gamma_0 \frac{I(z)}{1 + I(z)/I_s}.$$
(24)

Zgodnie z twierdzeniem o pochodnej funkcji odwrotnej

$$\frac{dz(I)}{dI} = \frac{1 + I/I_s}{\gamma_0 I},\tag{25}$$

równanie różniczkowe (24) można rozwiązać w oparciu o separację zmiennych

$$z(I) = z_0 + \frac{1}{\gamma_0} \left(\ln I + I/I_s \right).$$
(26)

Nakładając na równanie (25) warunek brzegowy $z(I_0) = 0$ otrzymujemy

$$z(I) = \frac{1}{\gamma_0} \left[\ln(I/I_0) + (I - I_0)/I_s \right].$$
(27)

Przekształcając powyższe równanie i korzystając z definicji tzw. funkcji W Lamberta otrzymujemy

$$\frac{I}{I_s} = W_0 \left(\frac{I_0}{I_s} \mathrm{e}^{\gamma_0 z + I_0/I_s} \right) \tag{28}$$

Przyjmując jadnak, że mamy do czynienia ze stosunkowo słabymi strumieniami światła $(I(z)/I_s \ll 1)$, rozwijając mianownik równania (24) w szereg Taylora ze wzgl. na $I(z)/I_s$, otrzymujemy równanie różniczkowe

$$\frac{dI(z)}{dz} = \gamma_0 I(z) \left(1 - \frac{I(z)}{I_s} + o(I(z)/I_s) \right),$$
(29)

którego rozwiązanie ma postać

$$I(z) = I_0 \left(\frac{I_0}{I_s} + \left(1 - \frac{I_0}{I_s}\right) e^{-\gamma_0 z}\right)^{-1},$$
(30)

gdzie I_0 , tak jak powyżej, jest natężeniem światła na wejściu ośrodka, tzn. $I(z = 0) = I_0$. Po prostych przekształceniach otrzymujemy, że

$$\frac{1}{I(z)} = \frac{1}{I_0} e^{-\gamma_0 z} + \frac{1}{I_s} \left(1 - e^{-\gamma_0 z} \right), \tag{31}$$

czyli liniową zależność pomiędzy odwrotnością natężenia wiązki w określonej odległości z ośrodka a odwrotnością jej natężenia na wejściu do tego ośrodka. Ostatecznie, mierząc natężenie wiązki laserowej na wejściu do światłowodu EDF (I_0) oraz na jego wyjściu $(I(z = L) = I_L)$ otrzymujemy zależność liniową postaci:

$$y = ax + b, (32)$$

gdzie
$$x = 1/I_0, y = 1/I_L, a = e^{-\gamma_0 L}$$
 i $b = (1 - e^{-\gamma_0 L})/I_s$

5.5 Włókno domieszkowane erbem jako ośrodek wzmacniający

Konfiguracja elektronowa stanu podstawowego jonu Er^{3+} to [Kr]4d¹⁰4f¹¹5s²5p⁶ (symbol [Kr] oznacza tu rdzeń odpowiadający konfiguracji elektronów atomu kryptonu). Oddziaływania spin-spin i spin-orbita w przypadku niecałkowicie zapełnionej powłoki 4*f* prowadzą do pojawienia się wielu poziomów jak to pokazano na Rys. 13. W wyniku oddziaływania z materiałem macierzystym (szkłem), a konkretnie mikropolami sieci krystalicznej, każdy z tych poziomów ulega rozszczepieniu na skutek efektu Starka.

Przejście z pierwszego stanu wzbudzonego ${}^{4}I_{13/2}$ do stanu podstawowego ${}^{4}I_{15/2}$ zachodzi z emisją fali o długości 1540 nm. Długość emitowanej fali jest bardzo słabo modyfikowana przez materiał macierzysty ponieważ elektrony na powłoce 4f są dobrze izolowane od otoczenia przez zapełnione powłoki 5s i 5p.

Widmo fluorescencji jonów erbu charakteryzuje się szerokim pasmem wyśrodkowanym na długości fali 1550 nm. Emisję w tym zakresie spektralnym można otrzymać poprzez pompowanie optyczne promieniowaniem z zakresu długości fal: 800 nm, 980 nm lub 1480 nm, które jest silnie absorbowane. Lasery o takich długościach fal mogą być zatem używane jako źródła wzbudzenia.

Oprócz procesów absorpcji fotonów pompujących i emisji fotonów użytecznych z punktu widzenia wzmocnienia optycznego, istnieje szereg innych procesów bezpośrednio wpływających na kształt widm absorpcyjnego i emisyjnego. Mianowicie, fotony użyteczne w procesie wzmocnienia i fotony pompujące są reabsorbowane przez jony w stanach wzbudzonych (patrz Rys. 13b-d). Prowadzi to do zmniejszenia liczby fotonów użytecznych i w efekcie zmniejszenia wzmocnienia. Całkowity współczynnik wzmocnienia wzmacniacza światłowodowego jest wypadkową wielu czynników takich jak: a) koncentracja jonów erbu, b) tłumienność światłowodu, c) przekrywanie się modów, d) długość fali źródła pompującego, e) przekrój czynny na absorpcję, f) promieniowania pompującego, g) proces konwersji w górę, h) migracja wzbudzenia i tłumienie nieradiacyjne, i) absorpcja przez jony w stanach wzbudzonych.

Podstawowym procesem fizycznym odpowiedzialnym za wzmocnienie jest emisja wymuszona. Układ poziomów energetycznych bezpośrednio zaangażowanych w proces wzmocnienia został przedstawiony na Rys. 14.



Rysunek 13: Schematyczny układ poziomów energetycznych 4f jonu Er^{3+} . a) przejście 1540 nm, strzałki oznaczają wzbudzenie przy użyciu światła o długościach fal 980 nm i 1480 nm. b) proces konwersji w górę, przy którym oddziaływanie pomiędzy dwoma wzbudzonymi jonami Er^{3+} prowadzi do obsadzenia wyżej położonych poziomów energetycznych. c) i d) procesy absorpcji fotonów przez wzbudzone jony odpowiednio fotonów o długości fali 1480 nm i 980 nm.



Rysunek 14: Uproszczona struktura poziomów energetycznych wzmacniacza typu EDFA.

Wzmacniacz typu EDFA działa w układzie zbliżonym do 3-poziomowego, a pompowanie odbywa się na długości fali 980 nm. Pompowanie następuje ze stanu podstawowego 1 do stanu górnego 2 z wykorzystaniem krótkożyciowego poziomu 3. Ponieważ stan dolny przejścia wzmacniającego jest bliski podstawowego, dlatego też uzyskanie inwersji obsadzeń wymaga silnego pompowania.

6 DODATKI

6.1 Procedura uruchamiania i obsługi diód laserowych firmy *Amonics*

Panele przedni i tylny sterowników laserów diodowych 980nm i 1550nm zostały przedstawione na Rys. 15, a procedura ich uruchamiania i obsługi przedstawia się następująco:

- 1. Upewnić się o prawidłowości podłączenia lasera do układu zasilania.
- 2. Przekręcić kluczyk blokady na tylnym panelu sterownika do pozycji UNLOCK.
- 3. Włączyć laser przez ustawienie na pozycji 1 włacznika znajdującego się na przednim panelu.
- 4. Za pomocą pokrętła-przycisku (3) należy przejść do zakładki LASER CONTROL na wyświetlaczu i w polu Iset przełączyć opcję OFF na STBY UWAGA: Należy wcześniej sprawdzić prawidłowość wszystkich połączeń światłowodowych w układzie, w szczególności podłączenia światłowodu do wyjścia lasera (5).
- 5. Nacisnąć przycisk emisji lasera (4), co powinno spowodować włączenia zielonej diody kontrolnej LED wewnątrz przycisku oraz przełączenie opcji STBY na ON. UWAGA: W przypadku zaistnienia potrzeby natychmiastowego przerwania emisji wiązki laserowej należy nacisnąć przycisk (4).
- 6. Aby uzyskać wiązkę o pożądanej mocy, za pomocą przycisku-pokrętła (3) przejść do pola Iset i ustawić odpowiednią wartość natężenia prądu zasilania diody. W przypadku lasera 1550 nm możliwe jest również osłabianie wiązki na wyjściu za pomocą wbudowanego osłabiacza (6), którego ustawienie regulujemy śrubokrętem. Zaleca się na początku ćwiczeń ustawienie minimalnego osłabienia (maksymalna moc) i regulowanie mocy wiązki za pomocą zmian natężenia prądu zasilania.
- 7. poszczególne pozycje na panelu Laser Control oznaczają:



Rysunek 15: a). Przedni panel sterowników lasera 980nm (góra) i 1550nm (dół): (1) – włącznik, (2) – wyświetlacz, (3) – pokrętło-przycisk do wyboru funkcji i sterowania, (4) – emisji lasera, (5) – wyjście światłowodowe, (6) – pokrętło osłabiacza wiązki, (7) – wejście do wewnętrznego miernika mocy ooptycznej. b) Tylny panel sterowników lasera 980nm (góra) i 1550nm (dół).

- $\bullet~{\rm P}_{\rm DFB}$ moc optyczna lasera 1550 nm mierzona za pomocą wewnętrznego miernika mocy,
- P_{RX} moc optyczna sygnału wprowadzonego z zewnątrz wejściem (7),
- $\bullet~{\rm P_{out}}-{\rm moc}$ optyczna lasera 980 nm mierzona za pomocą wewnętrzenego miernika mocy
- 8. Status lasera określany jest przez następujące stany:
 - ON emisja laserowa włączona,
 - STBY tryb oczekiwania, w którym emisja laserowa może zostać właczona przez naciśnięcie przycisku (4),
 - OFF emisja lasera wyłączona,
 - LOCK tryb blokady, w którym włączanie emisji lasera jest zablokowane.

6.2 Funkcja W Lamberta

Określona na półprostej $[-1,\infty)$ funkcja $f(x) = xe^x$ jest ciągła i rosnąca, a zbiorem jej wartości jest półprosta $[-1/e,\infty)$. Można więc jednoznacznie zdefiniować funkcję $W: [-1/e,\infty) \rightarrow$ $[-1,\infty)$ odwrotną do f, tj. taką, że W(f(x)) = x dla każdego $x \ge -1/e$. Funkcję tę nazywa się



Rysunek 16: Funkcja W Lamberta.

obecnie **funkcją W Lamberta**, ponieważ zagadnienia z nią związane rozważane były już przez osiemnastowiecznego matematyka Johanna Heinricha Lamberta (a także przez Eulera). Przydaje się ona do opisu rozwiązań ważnych w zastosowaniach równań różniczkowych z opóźnieniem i niektórych równań fizyki kwantowej, a także, jako funkcja tworząca, w kombinatoryce. Dla wprawki, czytelnik zechce sprawdzić, że $-\frac{3}{\ln 3}W(-\frac{1}{3}\ln 3)$ jest rozwiązaniem równania $3^x = x^3$ i ustalić, czy liczba ta jest mniejsza od 3. W wielu platformach obliczeniowych funkcja W lamberta występuję jako ProductLog[x].

Literatura

- [1] B. Ziętek, Lasery, Wydawnictwo UMK, Toruń 2009. 2007.
- [2] E. Hecht, *Optyka*, PWN 2012.
- [3] B. Ziętek, Optoelektronika, Wydawnictwo UMK, Toruń 2005.
- [4] www.tpub.com/neets/tm/108-9.htm

- [5] P.G. Kik and A. Polman, Erbium doped optical waveguide amplifiers on silicon, MRS Bulletin 23(4), 48 1998.
- [6] B.J. Ainslie, S.P. Craig, and S.T. Davey, The Absorption and Fuorescence Spectra of Rare-Earth Ions in Silica-Based Monomode Fiber, IEEE Journal of Lightwave Technology 6(2), 287 (1988).
- [7] B.J. Ainslie, A Review of the Fabrication and Properties of Erbium-Doped Fibers for Optical Amplifiers, IEEE Journal of Lightwave Technology 9(2), 220 (1991).